



DS89C430

超高速闪存微控制器

www.maxim-ic.com.cn

修订版 A2 勘误表

下面的勘误表列出了DS89C430修订版A2器件性能与预期值或数据资料描述不一致的情况。Dallas Semiconductor将在随后的裸片修订版中纠正这些问题。

本勘误表仅适用于DS89C430修订版A2器件。修订版A2器件在封装顶部印有一个yywwA2样式的六位代码，其中yy和ww两位分别表示器件的生产年份和周数。如需获得另一DS89C430裸片修订版的勘误表，请访问我们的网站www.maxim-ic.com.cn/errata。

1. 引导加载程序的整体擦除命令不能擦除选项控制寄存器

说明:

引导加载程序的整体擦除命令不能将OCR复位为FFh，导致看门狗定时器上电复位缺省位如果先前被清零时，不能被置成1。

补救措施:

如果看门狗定时器上电复位缺省位被清零，需要置1时，可以在应用程序中或并行编程模式下调用擦除选项控制寄存器命令。

2. 晶振倍频模式对断电摆率的要求

说明:

晶振倍频模式(CTM = 1)下，微控制器可能在持续低电源电压($0.4 < V_{CC} < V_{RST}$)时不能复位。

补救措施:

执行一次完整的关断($V_{CC} = 0$)过程清除这一问题。缺省模式下(每个机器周期为1个时钟周期)，这一错误不会发生，因此也不需要相应的解决方法。

使用晶振倍频器时，无论是2X还是4X模式，在 V_{CC} 电压降低到 V_{RST} 之前，器件都必须恢复到缺省的sysclk/1模式，按照下面步骤采用电源失效中断可达到这一目的：

- 1) 使用晶振倍频器前首先使能电源失效中断寄存器。可在CTM置位前任何时间将EPFI (WDCON.5)置位。
- 2) 0033h处的第一条指令(电源失效中断服务程序的起始地址)必须是ORL PMR, #80h。这条指令使晶振倍频器无效，并将器件恢复成缺省的sysclk/1模式。如果需要，后面可以跟随用户自定义的电源失效中断服务程序。如果没有用户自定义的电源失效中断服务程序，下一条指令应该是死循环。

3. 使用外部存储器时MOVC指令不能正常工作

说明:

当EA = 0并且MOVC的目标地址，@A + PC，位于微控制器外部程序存储器时，下面的指令将不能正常工作。

```
MOVC A, @A + DPTR
```

```
MOVC A, @A + PC
```

补救措施:

在位于内部闪存的存储器上执行所有的MOVC指令。

4. 在安全等级4不能执行外部MOVX指令

说明:

设置为安全等级4 (LB3清零，LB2和LB1为任意状态)时，内部代码不能访问外部MOVX存储器。而数据资料中给出的等级4说明允许访问外部MOVX存储器。

补救措施:

审查具体应用需要的安全等级，如果可能选择更适合的安全等级。

5. 锁存位安全等级1、2、3不能正常发挥作用

说明:

安全等级1、2、3不能正常发挥作用，如果使用外部程序存储器，可能无法排除对内部闪存存储器的访问。

补救措施:

需要保护内部闪存存储器时，使用安全等级4。